

PEGASUS HDP-CVD

PEGASUS HDP-CVDは、高密度プラズマを使い先端デバイス（メモリ、パワーデバイス、パッケージ）に高品位の膜を成膜します。

【低温成膜】

・ 200°C以下のSiO₂膜

屈折率	耐電圧	リーク電流	TDS（水素量）	膜密度
1.46	10MV	$2 \times 10^{-9} \text{A/cm}$	$2.2 \times 10^{15} \text{m/cm}^2$	2.23g/cm^2

・ 100°C以下のSiN膜

屈折率	水蒸気透過率	光透過率	応力	膜密度
~2.1	0.00001g/m^2	~0.0001	-100MPa	2.68g/cm^2

・ 100°C以下のカーボン膜

屈折率	密度	ID/IG	水素量	応力
1.9	1.9g/cm^2	0.3	23%	~700MPa

【超厚膜】

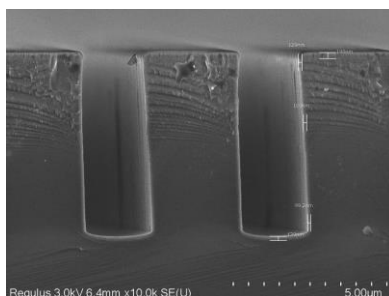
- ・ 20 μm を1回の処理で成膜

【高速成膜】

- ・ SiO₂：500nm/minの速度で処理が可能

【TSV成膜】

- ・ 側壁膜の形成
(200°C以下)



SiO₂膜

- ・ 上面：193nm
- ・ 側面：109nm
- ・ 底面：139nm